Механизм модификации зонного спектра и сверхпроводящих свойств в системе Tl₂Ba₂Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z

© О.А. Мартынова, В.Э. Гасумянц

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 195251 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: Olya218@yandex.ru

(Поступила в Редакцию 29 декабря 2006 г.)

Исследован характер модификации температурных зависимостей коэффициента термоэдс в системе $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ при изменении содержания легирующих примесей. Показано, что модель асимметричной узкой зоны применима к высокотемпературным сверхпроводникам таллиевой системы. На основе анализа температурных зависимостей коэффициента термоэдс в рамках модели узкой зоны определены значения параметров зонного спектра и системы носителей заряда для образцов близкого к оптимальному состава, а также проанализированы характер и механизм их изменения при переходе в слаболегированный режим совместно с динамикой сверхпроводящих свойств. Выявлена корреляция между значениями критической температуры T_c и эффективной шириной проводящей зоны W_D , показано, что зависимость $T_c(W_D)$ для $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ имеет близкий к универсальному характер, однако подавление T_c при расширении зоны происходит быстрее, чем в случае иттриевой системы.

PACS: 74.25.Fy, 74.72.Jt, 74.25.Jb, 74.62.Dh

1. Введение

Наряду с высокотемпературными сверхпроводниками (ВТСП) на основе висмута и ртути таллиевая система Tl₂Ba₂Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4} представляет собой интересный объект исследования с точки зрения изучения характера и механизма модификации свойств нормального и сверхпроводящего состояния при легировании, а также взаимосвязи между их параметрами. Это связано прежде всего с тем, что в таллиевой системе достаточно легко реализуемы различные режимы легирования (слабое и сильное легирование), включая получение образцов с избыточным содержанием кислорода, что практически недостижимо в случае системы YBa2Cu3Ov. Кроме того, в системе $Tl_2Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$ возможно изменение свойств путем варьирования числа медь-кислородных слоев *п*. Исследования кристаллической структуры и сверхпроводящих свойств Tl₂Ba₂Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4} при различных *п* позволили определить характер влияния числа медь-кислородных слоев на значение критической температуры сверхпроводящего перехода T_c в данных соединениях [1–3]. Установлено, что при $n \le 3$ значение T_c существенно возрастает с ростом *n*. Выявлены также основные особенности электронных явлений переноса в системе $Tl_2Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$, в том числе температурных зависимостей удельного сопротивления $\rho(T)$ и коэффициента термоэдс S(T) [4–13]. Однако, несмотря на достаточно большой объем экспериментальных данных, их анализ сильно затруднен вследствие сложной кристаллической структуры таллиевых ВТСП и их дефектности, в особенности в случае фаз с n > 1. В результате авторы большинства работ, посвященных особенностям электронного транспорта, ограничиваются обсуждением общего характера зависимостей S(T) и лишь качественным анализом влияния легирования на значение коэффициента термоэдс. В то же время представлет несомненный интерес возможность определения количественных характеристик нормального состояния. Одной из моделей, позволяющей на основе анализа температурных зависимостей кинетических коэффициентов получать информацию о структуре зонного спектра, является модель узкой зоны [14]. Проведенные ранее исследования показали, что в случае оптимальных составов каждой из фаз Tl₂Ba₂Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4} с различным nувеличение Т_с с ростом числа медь-кислородных слоев коррелирует с изменением основных параметров зонного спектра $Tl_2Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2n+4}$ в нормальном состоянии [15], в первую очередь со значением эффективной ширины зоны, ответственной за проводимость. Однако детального исследования характера влияния легирования в рамках различных фаз ранее не проводилось.

В связи с этим целью данной работы являлось проведение систематического анализа характера модификации зонного спектра таллиевых сверхпроводников при легировании в сравнении с наблюдаемым изменением сверхпроводящих свойств.

Особенности температурных зависимостей коэффициента термоэдс

В качестве объекта исследования была выбрана система $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$, для которой в литературе имеются систематические экспериментальные данные (для 23 образцов, изготовленных в едином технологическом цикле) о температурных зависимостях коэффициента термоэдс в случае образцов с различным уровнем легирования как кобальтом, так и иттрием [5].

Все образцы были изготовлены матричным методом из соответствующих оксидов и карбонатов и являлись однофазными.

Для всех образцов исследованной системы был проанализирован вид температурных зависимостей коэффициента термоэдс. В качестве примера на рис. 1 и 2 представлены зависимости S(T) для некоторых образцов с различными типами легирования — $Tl_2Ba_2Ca_{0.9}Y_{0.1}Cu_{2-y}Co_yO_z$ (y = 0-0.12) и $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{0.92}Co_{0.08}O_z$ (x = 0-0.25) соответственно. Во всех случаях как вид зависимостей S(T)для всех образцов, так и их трансформация при переходе от оптимального с точки зрения сверхпроводящих свойств уровня легирования к слаболегированному составу обладают особенностями, характерными для всех бесцепочечных ВТСП [16]. Так, для образцов с уровнем легирования, близким к оптимальному (при малом



Рис. 1. Температурные зависимости коэффициента термоэдс в Tl₂Ba₂Ca_{0.9}Y_{0.1}Cu_{2-y}Co_yO_z. Точки — эксперимент [5], линии — расчет по модели узкой зоны.



Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента термоэдс в Tl₂Ba₂Ca_{1-x}Y_xCu_{0.92}Co_{0.08}O_z. Точки — эксперимент [5], линии — расчет по модели узкой зоны.



Рис. 3. Концентрационные зависимости величины критической температуры в $Il_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$.

уровне легирования как кобальтом, так и иттрием), на зависимостях коэффициента термоэдс от температуры наблюдается выраженный максимум при температуре выше температуры сверхпроводящего перехода, а также протяженный участок практически линейного падения величины *S* с увеличением температуры при температурах выше этого максимума вплоть до T = 300 K. Значение коэффициента термоэдс при T = 300 K S₃₀₀ для оптимально легированых образцов составляет $0.3-8 \mu$ V/K.

Абсолютные значения коэффициента термоэдс для слаболегированных образцов выше, чем в случае оптимальных составов, а величина S_{300} последовательно возрастает с ростом уровня легирования кобальтом и иттрием в диапазоне $12.5-60 \mu$ V/K вследствие большей валентности замещающего элемента относительно замещаемого. Также с ростом уровня легирования линейность зависимостей S(T) пропадает, а максимум на них становится более размытым и смещается в область более высоких температур.

Зависимости критической температуры от концентрации примесей для исследованной системы представлены на рис. 3. Видно, что введение как иттрия, так и кобальта приводит к уменьшению T_c . При этом, если в случае замещения Со \rightarrow Си во всем исследованном диапазоне легирования зависимость $T_c(y)$ является линейной, то в случае замещения Y \rightarrow Са наблюдаются два различных участка на зависимости $T_c(x)$: слабое уменьшение T_c при $x \leq 0.1$, которое при $x \geq 0.1$ сменяется более сильным подавлением сверхпроводящих свойств.

3. Анализ экспериментальных данных и интерпретация результатов

Модель узкой зоны, в рамках которой проводился анализ температурных зависимостей коэффициента термоэдс для исследованной системы, подробно описана

в работе [14]. Основное положение данной модели наличие в зонном спектре ВТСП-материалов узкого пика плотности состояний вблизи уровня Ферми, в результате чего основной вклад в процессы переноса вносят именно носители заряда, находящиеся в области этого пика. Модель узкой зоны позволяет получить аналитические выражения для температурых зависимостей кинетических коэффициентов, используя три модельных параметра (F — степень заполнения зоны электронами, равная отношению полного числа электронов *n* к числу состояний в зоне (F = n/N), *W_D* — полная эффективная ширина зоны, *W_σ* — ширина зоны "по проводимости") в случае симметричной зоны и четыре (с учетом дополнительного параметра *b* — параметра степени асимметрии зоны) в случае асимметричной зоны. Варьируя эти параметры и добиваясь наилучшего согласия экспериментальных и расчетных температурных зависимостей коэффициента термоэдс, можно определить их значения для каждого из исследуемых образцов и проследить за их трансформацией при различных отклонениях от стехиометрии [14].

Вид зависимостей S(T) для $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$, как и результаты, полученные ранее для других бесцепочечных ВТСП-систем [14,17,18], указывают на то, что для анализа коэффициента термоэдс в исследуемой системе необходимо привлечение предположения о слабой асимметрии проводящей зоны. Необходимо отметить, что при использовании симметричной модели узкой зоны набор модельных параметров для конкретного образца определяется по зависимости S(T)однозначно [14]. Введение четвертого параметра b ведет к расширению диапазона возможного варьирования остальных параметров, что может приводить к неоднозначности их определения. Чтобы оценить степень этой неоднозначности, расчет параметров зонного спектра для каждой экспериментальной зависимости S(T) осуществлялся многократно при фиксированных значениях либо параметра $C = W_{\sigma}/W_D$, либо параметра *b*. Это позволило определить возможный диапазон изменения данных параметров, который составил 0.2-0.4 для параметра C и -(0.03-0.07) для параметра b. На основе полученных результатов были проведены расчеты для каждого образца с целью получениях всех возможных наборов модельных параметров, позволяющих удовлетворительно описать экспериментальные зависимости S(T), полученные для этого образца. Таким образом, для каждого конкретного образца был определен возможный диапазон варьирования каждого из четырех параметров. Величина этого диапазона может, таким образом, рассматриваться как погрешность в определении значений параметров модели, возникающая при учете асимметрии проводящей зоны. На рис. 1, 2 линиями показаны расчетные кривые S(T), полученные в случае оптимальных значений модельных параметров и демонстрирующие степень согласия с экспериментальными данными.



Рис. 4. Концентрационные зависимости степени заполнения зоны электронами (*a*) и полной эффективной ширины проводящей зоны (*b*) в $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ для случая замещения $Y \rightarrow Ca$.

Результаты расчетов для концентрационных зависимостей степени заполнения зоны электронами F и ее эффективной ширины W_D представлены на рис. 4, 5 (с указанием погрешности в их определении). Видно, что замещение У — Са в целом приводит к росту значений F (при этом зависимость F(x) является нелинейной), причем скорость возрастания значения F увеличивается с ростом содержания иттрия, в то время как при замещении Co \rightarrow Cu зависимость F(y) является немонотонной (рис. 4, *a* и 5, *a*). Что касается параметра W_D , то, как видно из рис. 4, b и 5, b, обе примеси приводят к его росту. При этом в случае замещения Со → Си расширение проводящей зоны отчетливо наблюдается уже в области малых концентраций, в то время как для У — Са оно становится заметным только при x > 0.1 (при x < 0.1наблюдается фактически постоянство значения W_D). Как указывалось выше, именно до этого значения содержания иттрия на зависимости $T_{\rm c}(x)$ наблюдается участок слабого уменьшения критической температуры. Отметим, что значения параметра $C = W_{\sigma}/W_D$, характеризующего степень делокализации состояний в проводящей



Рис. 5. Концентрационные зависимости степени заполнения зоны электронами (a) и полной эффективной ширины проводящей зоны (b) в Tl₂Ba₂Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z для случая замещения Co \rightarrow Cu.

зоне, в $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ слабо уменьшаются в случае увеличения уровня легирования как кобальтом, так и иттрием. В целом характер трансформации зонного спектра с ростом уровня легирования аналогичен обнаруженному ранее для других ВТСП-систем [14] и связан, по нашему мнению, с внесением примесями разупорядочения в структуру, приводящего, согласно механизму андерсоновской локализации, к общему расширению проводящей зоны и увеличению доли локализованных состояний на ее краях. В рамках данного механизма обнаруженное более сильное воздействие кобальта на трансформацию проводящей зоны в области малых концентраций по сравнению с замещением У — Са может быть объяснено с учетом того, что кобальт, замещая непосредственно медь в плоскостных позициях, оказывает сильное разрушающее действие на проводящую зону, сформированную перекрытием орбиталей меди и кислорода. В результате воздействие кобальта на увеличение эффективной ширины проводящей зоны включает в себя два механизма: разрушение проводящей зоны за

счет замещения кобальтом медь-плоскостных позиций, ответственных за проводимость, и расширение зоны по Андерсону вследствие разупорядочения. Очевидно, что суммирование этих двух механизмов должно уже при малых концентрациях кобальта ($y \le 0.1$) приводить к более сильному расширению проводящей зоны по сравнению с наблюдаемым для замещения $Y \rightarrow Ca$, где единственным механизмом расширения проводящей зоны является механизм андерсоновской локализации состояний.

Обнаруженная динамика степени заполнения зоны электронами может быть объяснена следующим образом. Замещение У — Са является неизовалентным, при этом валентность замещаемого элемента является меньшей, чем валентность элемента, его замещающего. Исходя из кристаллохимических соображений такое замещение должно приводить к увеличению числа электронов, что в свою очередь должно способствовать росту F. Это полностью объясняет растущий вид зависимости F(x). Для объяснения ее нелинейности необходимо привлечь высказанное ранее предположение о механизме воздействия кальция на зонный спектр YBa₂Cu₃O_v. В работах [14,19] был сделан вывод о появлении в проводящей зоне дополнительных "кальциевых" состояний (что соответствует увеличению значения N с ростом содержания кальция). Это приводит к появлению дополнительного пика плотности состояний D(E) и вызывает асимметрию проводящей зоны. По аналогии с иттриевой системой можно предположить, что в случае $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ уменьшение содержания кальция должно приводить к уменьшению числа состояний в зоне. В результате на зависимость F(x) в случае замещения $Ca \rightarrow Y$ должны оказывать влияние одновременно два фактора: увеличение числа электронов и уменьшение числа состояний в зоне. Ясно, что в таком случае зависимость F(x) должна быть нелинейной, причем ее наклон должен именно увеличиваться с ростом содержания иттрия, что и соответствует результатам расчетов.

Обратимся теперь к объяснению данных, полученных для случая замещения Co — Cu. Очевидно, что замещение Co — Cu, как и в случае Y — Ca, приводит к изменению зарядового баланса в решетке за счет внесения в нее кобальтом избыточного заряда (валентность кобальта выше, чем у замещаемой им меди) и, следовательно, ведет к увеличению n, что должно способстововать росту значения F. Однако, как следует из расчетов, последовательного увеличения значения F не происходит — зависимость F(y) имеет немонотонный вид. Можно предположить, что в данном случае значительный вклад дает другой эффект, который уже был упомянут выше для интерпретации данных о модификации проводящей зоны, — разрушение проводящей зоны, сформированной перекрытием орбиталей меди и кислорода. Суммарный учет указанных выше двух эффектов и приводит к немонотонному изменению F в случае замещения Со → Си.



Рис. 6. Корреляционная зависимость $T_c(W_D)$ для системы $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ в сравнении с данными для легированного $YBa_2Cu_3O_y$.

В заключение сопоставим изменение параметров зонного спектра в нормальном состоянии со сверхпроводящими свойствами в исследованном соединении. Как было показано ранее [14], для ВСТП-системы УВа₂Си₃О_у при различных катионных замещениях существует универсальная корреляция между значениями T_c и W_D. Наличие данной корреляции интерпретировалось ранее как указание на то, что основной причиной подавления сверхпроводящих свойств в иттриевой системе при легировании является расширение проводящей зоны, приводящее к уменьшению значения функции плотности состояний на уровне Ферми $D(E_{\rm F})$. На основе данных, полученных нами для системы $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$, была построена зависимость $T_{\rm c}(W_D)$ для этой системы, приведенная на рис. 6 вместе с аналогичной кривой для $YBa_2Cu_3O_{\nu}$ при различных катионных замещениях [14]. Как видно из рис. 6, зависимость $T_{c}(W_{D})$ для системы $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ также имеет универсальный характер, однако подавление Т_с при расширении зоны происходит значительно быстрее. Наличие подобной корреляции указывает на то, что в системе Tl₂Ba₂CaCu₂O₇ (аналогично иттриевым ВТСП) параметры системы носителей заряда в нормальной фазе оказывают непосредственное воздействие на значение критической температуры. Кроме того, отметим, что в рамках используемой нами модели значение W_D обратно пропорционально величине $D(E_{\rm F})$. В то же время известно, что в различных предложенных механизмах высокотемпературной сверхпроводимости значение T_c должно зависеть (как и в классической теории БКШ) от двух параметров — значений функции плотности состояний на уровне Ферми и матричного элемента, описывающего взаимодействие, приводящее к спариванию электронов. Следовательно, обнаруженное различие в зависимостях $T_{\rm c}(W_D)$ для иттриевых и таллиевых ВТСП позволяет предположить, что в последнем случае неизовалентное легирование приводит, наряду с падением $D(E_{\rm F})$, к более сильному уменьшению значения матричного элемента спаривания.

4. Заключение

Таким образом, на основе анализа особенностей электронного транспорта в системе $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ получены следующие результаты.

1) Показано, что модель асимметричной узкой зоны применима к ВТСП таллиевой системы и позволяет определить значения основных параметров зонного спектра для образцов оптимального состава, а также выявить тенденции в их изменении при переходе к слаболегированным составам.

2) Обнаружено, что с увеличением уровня легирования как кобальтом, так и иттрием происходит последовательное расширение зоны, сопровождающееся увеличением доли локализованных носителей заряда. Причиной этой трансформации зонного спектра является механизм андерсоновской локализации состояний, вызванной возрастающей степенью разупорядочения структуры. В случае замещения Со → Си дополнительный вклад в расширение зоны вносит эффект ее разрушения за счет замещения кобальтом позиций меди, ответственных за проводимость.

3) Сделан вывод об уменьшении числа зонных состояний при замещении в $Tl_2Ba_2Ca_{1-x}Y_xCu_{2-y}Co_yO_z$ кальция иттрием. Это позволяет, совместно с учетом эффекта изменения зарядового баланса в решетке, полностью объяснить динамику степени заполнения зоны электронами для замещения Ca \rightarrow Y.

4) Выявлена корреляция между значениями T_c и W_D . Показано, что зависимость $T_c(W_D)$ в исследованной системе имеет близкий к универсальному характер, однако подавление T_c при расширении зоны происходит быстрее, чем в случае иттриевой системы, что свидетельствует о более сильном влиянии легирования на значение матричного элемента, описывающего спаривание электронов.

Список литературы

- P. Mandal, A. Poddar, P. Choudhury, A.N. Das, B. Ghosh. Ind. J. Pure Appl. Phys. **30**, 531 (1992).
- [2] M.A. Tanatar, V.S. Yefanov, V.V. Dyakin. Physica C 185–189, 1247 (1991).
- [3] T. Kaneko, K. Hamada, S. Adachi, H. Yamauchi, S. Tanaka. J. Appl. Phys. 71, 2347 (1992).

- [4] R. Awad, N.H. Mohammed. Supercond. Sci. Technol. 17, 35 (2004).
- [5] A. Poddar, B. Bandyopadhyay, B. Chattopadhyay. Physica C 390, 120 (2003).
- [6] Y. Xin, K.W. Wong, C.X. Fan, Z.Z. Sheng, F.T. Chan. Phys. Rev. B 48, 557 (1993).
- [7] C. Martin, J. Hejtmanek, Ch. Simon, A. Maignan, B. Raveau. Physica C 250, 235 (1995).
- [8] S.D. Obertelli, J.R. Cooper. Phys. Rev. B 46, 14928 (1992).
- [9] T. Kaneko, K. Hamada, S. Adachi, H. Yamauchi. Physica C 197, 385 (1992).
- [10] S. Keshri, J.B. Mandal, A. Poddar, A.N. Das, B. Ghosh. Phys. Rev. B 47, 9048 (1993).
- [11] L. Alcacer, M. Almeida, U. Braun, A.P. Goncalves, S.M. Green, E.B. Lopes, H.L. Luo, C. Politis. Mod. Phys. Lett. B 2, 923 (1988).
- [12] L.S. Yuan, L. Li, Z.D. Lin, H.M. Duan, A.M. Hermann. Europhys. Lett. 12, 641 (1990).
- [13] S.N. Bhatia, P. Chowdhury, S. Gupta, B.D. Padalia. Phys. Rev. B 66, 214 523 (2002).
- [14] V.E. Gasumyants. In: Advances in condensed matter and materials research. V. 1 / Ed. F. Gerard. Nova Sci. Publ., N.Y. (2001). P. 135.
- [15] V. Gasumyants, M. Elizarova. In: 8th Int. workshop "Hightemperature superconductors and novel inorganic materials engineering". Moscow (2004). P. 38.
- [16] A.B. Kaizer, C. Ucher. In: Advances in Studies of hightemperature superconductors. V. 7/Ed. A.V. Narkikar. Nova Sci. Publ., N.Y. (1991). P. 353.
- [17] M.V. Elizarova, A.O. Lukin, V.E. Gasumyants. Physica C 341– 348, 1825 (2000).
- [18] V.E. Gasumyants, N.V. Ageev, E.V. Vladimirskaya, V.I. Smirnov, A.V. Kazanskiy, V.I. Kaydanov. Phys. Rev. B 53, 905 (1996).
- [19] V.E. Gasumyants, M.V. Elizarova, E.V. Vladimirskaya, I.B. Patrina. Physica C 341–348, 585 (2000).